# 华中农业大学本科课程考试答案

考试课程与试卷类型: 大学物理学 A (A卷)

学年学期: 2018-2019-1

考试时间: 2019-1-10

一、判断题(判断下列表述,正确的在答题纸上相应位置把T涂黑,错误的在答题纸上相应位置把F涂黑,每小题 2 分,共 10 分。)

1.F 2.F 3.T 4.F 5.F

二、单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案,并将其代号在答题卡上相应的位置涂黑,每小题 2 分,共 20 分.)

1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B

三、应用题 (将解答过程填写在答题纸上相应位置,本题 10 分)

解:根据题目条件,可以得到最小分辨角为

$$\delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{555(nm)}{5(mm)} = 1.22 \times \frac{555 \times 10^{-9} (m)}{5 \times 10^{-3} (m)} = 135.42 \times 10^{-6} (rad)$$
 (7  $\%$ )

设两个点光源之间的距离为L,航天飞机到地面的距离为R,则两个点光源的距离为

$$L = R\delta\theta = 160(km) \times 135.42 \times 10^{-6} (rad)$$

$$=160\times10^{3}\times135.42\times10^{-6} (m)$$
 (3  $\%$ )

=21.67(m)

四、计算题(将解答过程填写在答题纸上相应位置,三小题,每题 12 分,共 36 分.) 第一题的解:

(1) 圆筒外部空间的磁感应强度分布: 由题目可知,磁场分布具有柱对称性. 因此,可作一个半径为r的圆形闭合回路 L,其圆心在圆筒的轴上. 于是,磁感应强度矢量  $\bar{B}$  的环流为

$$\oint_{I} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{I} Bdl \cos 0 = B \oint_{I} dl = B2\pi r \tag{4 }$$

该闭合回路L包围的总电流强度I,因此根据真空中的安培环路定理,

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum I \implies B 2\pi r = \mu_{0} I \implies B = \frac{\mu_{0}}{2\pi} \frac{I}{r} \quad (r > R)$$

$$(4 \%)$$

(2) 圆筒内部空间的磁感应强度分布:同样地,在圆筒内部作一个半径为r的圆形闭合回路 L'. 因为该回路所包围的电流为零. 因此根据真空中的安培环路定理,可知,圆筒内部没有磁

场. 
$$B=0$$
  $(r < R)$  (4分)

综上, 圆筒内、外空间各处的磁感应强度分布为

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$$
 方向与电流  $I$  的方向成右手螺旋定则.

## 第二题的解:

光在丙酮薄膜上下表面反射时,均存在半波损失. 因此,半波损失导致的附加光程差为零. 丙酮薄膜上下表面的反射光的光程差为  $\delta = 2dn$ . (4分)

根据干涉相消发生的条件,有

$$\delta = 2dn = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow d = \frac{(2k+1)\lambda}{4n} \tag{4 \%}$$

取k=0时,可以得到丙酮薄膜的最小厚度

当 
$$k = 0$$
 时,  $d = \frac{(2k+1)\lambda}{4n}$   

$$\Rightarrow d = \frac{\lambda}{4n} = \frac{600(nm)}{4 \times 1.25} = \frac{600 \times 10^{-9} (m)}{5} = 1.2 \times 10^{-7} (m)$$

## 第三题的解:

### (1)电场分布:

根据题意,电场分布具有球对称性,因此可以作一个半径为r的球形高斯面S,其电通量为

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S} EdS \cos 0 = E \iint_{S} dS = 4\pi r^{2} E$$

如果高斯面在球面外(r > R),根据高斯定理,有

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_{0}} \implies 4\pi r^{2} E = \frac{2Q}{\varepsilon_{0}} \implies E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_{0}r^{2}} \quad (r > R) \tag{3 \%}$$

如果高斯面在球面内(r < R),根据高斯定理,有

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_{0}} \implies 4\pi r^{2} E = \frac{Q}{\varepsilon_{0}} \implies E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_{0} r^{2}} (r < R)$$
(3 \(\frac{\gamma}{r}\))

综上, 球面内外空间各处的电场强度分布为

$$E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} (r < R) \\ \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r^2} (r > R) \end{cases}$$
方向沿径向朝外.

#### (2) 电势分布:

球面外的电势:在球面外任取一点 P,该点到球心的距离为  $r_p$ ,选无穷远处为电势能零点,且积分路径沿径向,则根据电势的定义,有

$$U_{P} = \int_{r_{p}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_{p}}^{\infty} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_{0}} \int_{r_{p}}^{\infty} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} \frac{Q}{r_{p}}$$

$$(3 \%)$$

球面内的电势:在球面内任取一点 P,该点到球心的距离为  $r_p$ ,选无穷远处为电势能零点, 且积分路径选为径向,则根据电势的定义,有

$$U_{p} = \int_{r_{p}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_{p}}^{R} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{R}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_{p}}^{R} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr + \int_{R}^{\infty} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}} \left( \frac{1}{r_{p}} - \frac{1}{R} \right) + \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} \frac{Q}{R} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}} \left( \frac{1}{r_{p}} + \frac{1}{R} \right)$$
(3 \(\frac{\frac{1}{r}}{r}\))

综上, 球面内外空间各处的电势分布

形象地和定性地描述磁场,而且可以定量地描述磁场.

$$U_{p} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{r_{p}} + \frac{1}{R}\right) & (r < R) \\ \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} \frac{Q}{r_{p}} & (r > R) \end{cases}$$

五、简答题(将解答过程填写在答题纸上相应位置,两小题,每题 12 分,本题 24 分.) 第一题:运动电荷、传导电流以及变化的磁场(位移电流)都可以产生磁场. (6 分) 这种说法是错误的.磁感线上每一点的切线方向与该点磁感应强度的方向一致,而且垂直于磁 场的单位面积上穿过磁感应线的条数,等于该处磁感应强度的大小.因此,磁感应线不但可以

(6分)

**第二题**:依据马吕斯定律,就可以把该光束的类型鉴别出来.具体操作如下:将这束入射光垂直入射到一块偏振片上,然后以入射光束为轴,旋转偏振片一周.如果光屏上的光强没有明显的变化,则该入射光为自然光(4分);如果光强在最大和最小之间变化,而且最小值为零,则该入射光为线偏振光(4分);如果光强在最大和最小之间变化,而且最小值不为零,则该入射光是由线偏振光与自然光混合而成的部分偏振光(4分).